

Procedeu de creștere a structurii $p^+InP-pInP-n^+CdS$ pentru celule fotovoltaice, care constă în aceea că, se crește stratul de $pInP$ pe un substrat, executat în formă de plachetă de p^+InP cu orientarea cristalografică (100), deorientarea de $3...5^\circ$ în direcția (110) și concentrația purtătorilor de sarcină de 10^{18} cm^{-3} , se depune, pe partea frontală a plachetei, prin metoda volumului cvasi închis stratul de n^+CdS , se depune pe partea posterioară a plachetei un contact ohmic din $Ag+5\%Zn$, se tratează termic la temperatura de $450^\circ C$, se depune un contact ohmic din In pe stratul de n^+CdS , se tratează termic la temperatura de $250^\circ C$, și se depune prin metoda evaporării cu fasciculul de electroni, la temperatura de $300^\circ C$, un strat antireflector de SiO_2 .